

VC-TCXO/TCXO  
超高精度

**NEW**



产品号码(请联系我们)  
TG5032CFN : X1G005391xxxxxx  
TG5032SFN : X1G005401xxxxxx

# TG5032CFN TG5032SFN

- 频率范围 : 10 MHz ~ 40 MHz
- 电源电压 : 3.3 V Typ.
- 频率温度特征 :  $\pm 0.1 \times 10^{-6}$  Max. (-40 °C ~ +85 °C)
- 频率老化 :  $\pm 3.0 \times 10^{-6}$  Max. / 20 年
- 外部尺寸 : 5.0 × 3.2 × 1.45 mm (4 引脚)
- 应用 : Small Cells, Stratum3
- 特性 : 超高精度, 广温度范围



实际尺寸

## 规格 (特征)

项目	符号	TG5032CFN (CMOS)		TG5032SFN (Clipped sine wave)		条件
		VC-TCXO	TCXO	VC-TCXO	TCXO	
输出频率范围	$f_0$	10 MHz ~ 40 MHz				标准频率
电源电压	$V_{CC}$	C: 3.3 V $\pm$ 5% (电源电压范围: 2.375 V ~ 3.63 V)				裸存
储存温度范围	$T_{stg}$	-40 °C ~ +90 °C				
工作温度范围	$T_{use}$	G: -40 °C ~ +85 °C				在回流焊后, +25 °C
a) 频率初期公差	$f_{tol}$	$\pm 1.0 \times 10^{-6}$ Max.				
b) 频率温度特征	$f_0-T_c$	A: $\pm 0.1 \times 10^{-6}$ Max. / G: -40 °C ~ +85 °C M: $\pm 0.14 \times 10^{-6}$ Max. / G: -40 °C ~ +85 °C B: $\pm 0.28 \times 10^{-6}$ Max. / G: -40 °C ~ +85 °C				频率( $f_{max}+f_{min}$ )/2 基准
c) 频率负载变动特征	$f_0-Load$	$\pm 0.1 \times 10^{-6}$ Max.				Load $\pm 10$ %
d) 频率电源电压特征	$f_0-V_{CC}$	$\pm 0.1 \times 10^{-6}$ Max.				$V_{CC} \pm 5$ %
e) 频率老化	$f_{age}$	$\pm 0.5 \times 10^{-6}$ Max.				+25 °C, 第一年
		$\pm 3.0 \times 10^{-6}$ Max.				+25 °C, 20 年
Holdover stability (温度固定)	—	$\pm 0.01 \times 10^{-6}$ Max. (+25 °C, 24 时间)				工作开始 10 日后基准
		$\pm 0.04 \times 10^{-6}$ Max. (+25 °C, 24 时间)				工作开始 48 时间后基准
Free-run accuracy	—	$\pm 4.6 \times 10^{-6}$ Max.				这包括项目 a), b), c), d), e).
功耗	$I_{CC}$	5.0 mA Max.		5.0 mA Max.		10 MHz $\leq f_0 \leq 26$ MHz
		6.0 mA Max.				26 MHz < $f_0 \leq 40$ MHz
输入电阻	$R_{in}$	100 k $\Omega$ Min.	—	100 k $\Omega$ Min.	—	Vc- GND (DC)
频率控制范围	$f_{cont}$	$\pm 5 \times 10^{-6}$ ~ $\pm 10 \times 10^{-6}$	—	$\pm 5 \times 10^{-6}$ ~ $\pm 10 \times 10^{-6}$	—	D: $V_c = 1.5 V \pm 1.0 V$ ( $V_{CC} = 3.3 V$ ) E: $V_c = 1.65 V \pm 1.0 V$ ( $V_{CC} = 3.3 V$ )
频率变化极	—	正极	—	正极	—	
占空比	SYM	45 % ~ 55 %		—		50 % $V_{CC}$ 极, $L_{CMOS} \leq 15 pF$
输出电压	$V_{OH}$	90 % $V_{CC}$ Min.		—		
	$V_{OL}$	10 % $V_{CC}$ Max.		—		
输出电压极	$V_{pp}$	—		0.8 V Min.		峰-峰值
上升/下降时间	$t_r / t_f$	8.0 ns Max.		—		10 % $V_{CC}$ ~ 90 % $V_{CC}$ 极, 负载: 15 pF
振荡启动时间	$t_{str}$	5.0 ms Max.				在 90 % $V_{CC}$ 时, 所需时间为 0 秒
输出负载	Load	15 pF		10 k $\Omega$ /10 pF		

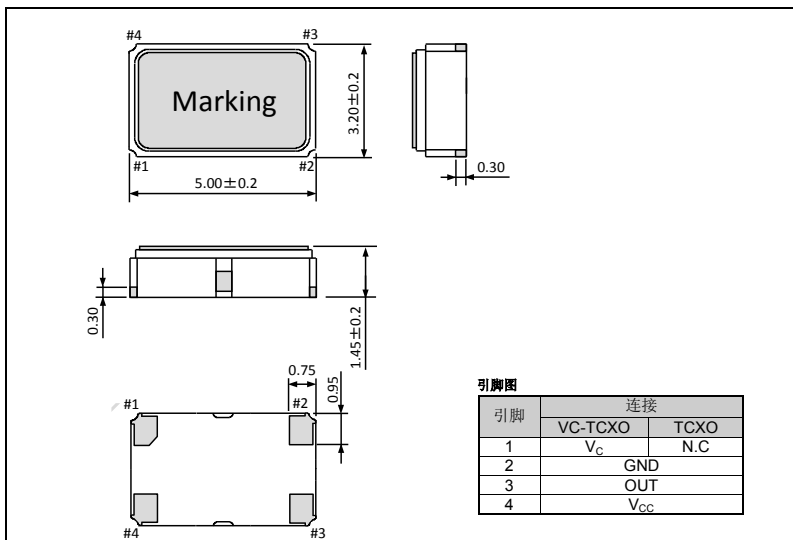
\*说明: 请联系我们以便获取上述内容未涉及的其他规格产品的相关信息

产品名称 **TG5032CFN30.720000MHz CAGND A**  
(标准显示) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

- ①型号 ②输出(C: CMOS, S: Clipped sine wave) ③频率 ④电源电压(C: 3.3 V Typ.)  
⑤频率温度特征(A:  $\pm 0.1 \times 10^{-6}$  Max., M:  $\pm 0.14 \times 10^{-6}$  Max., B:  $\pm 0.28 \times 10^{-6}$  Max.) ⑥工作温度范围(G: -40 °C ~ +85 °C)  
⑦OE 功能(N: 无) ⑧Vc 功能(A:  $V_c = any$ , D:  $V_c = 1.5 V$ , E:  $V_c = 1.65 V$ , N: 无) ⑨内部识别码(A: 默认)

## 外部尺寸规格

(单位:mm)



## 推荐焊盘尺寸

(单位:mm)

